

SOI WAFER		
器件层-顶层	最小值	最大值
晶体生长方法	CZ,FZ	
直径	2"	8"
厚度	0.05μm	> 300μm
公差	±5%	
晶向	(100),(110),(111)	
类型 / 掺杂剂	P/Boron,N/Phosphorus,Intrinsic	
电阻率	0.001ohm-cm	> 20000ohm-cm
正面	抛光面	
埋氧层-BOX LAYER	最小值	最大值
厚度	0.1μm	3μm
公差	±5%	
支撑衬底层	最小值	最大值
晶体生长方法	CZ,FZ	
直径	2"	8"
厚度	200μm	750μm
公差	±5%	
晶向	(100),(110),(111)	
类型 / 掺杂剂	P/Boron,N/Phosphorus,Intrinsic	
电阻率	0.001ohm-cm	> 20000ohm-cm
背面	带氧化层的蚀刻面 或 抛光面	
晶圆整体特性	最小值	最大值
TTV	< 5μm	
BOW	< 20μm	